

多功能宽密度等离子体CVD

Multi-functional Wide Density Plasma CVD

多功能宽密度等离子体CVD

SUNANO多功能宽密度等离子体CVD结合了电感耦合和电容耦合辉光放电的优点，可在宽密度工艺范围 ($10^9-10^{13} \text{ cm}^{-3}$)实现稳定的等离子体辅助CVD，具有优良的材料处理性能和广泛的应用范围，是目前全球功能最强大的等离子体CVD系统。

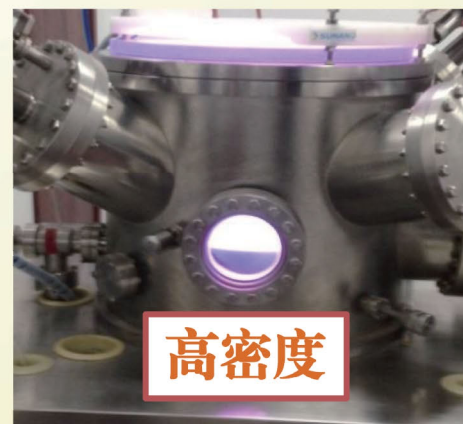
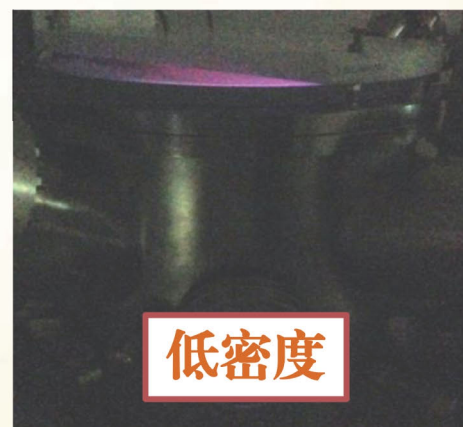


一个设备
多种用途!

主要特点

- 主要用于石墨烯表面层数减薄、刻蚀、修饰、改性
- 多种工作气体下产生稳定的等离子体辉光放电
- 氩气、氢气、氮气、氧气、硅烷、硼烷、磷烷、锗烷、甲烷、氨气、六氟化硫、四氟化碳、二氧化碳等
- 等离子体密度可调，变化范围大 ($10^9-10^{13} \text{ cm}^{-3}$)
- 可与磁控溅射同时工作形成共沉积（最多可与四个磁控溅射靶材形成等离子体辅助沉积），因而可沉积多种多样的化合物薄膜

低密度等离子体	中密度等离子体	高密度等离子体	多功能宽密度等离子体
$10^9-10^{10} \text{ cm}^{-3}$	$10^{11}-10^{12} \text{ cm}^{-3}$	$10^{12}-10^{13} \text{ cm}^{-3}$	$10^9-10^{13} \text{ cm}^{-3}$
薄膜制备	表面修饰、改性	刻蚀、晶片清洗	高质量薄膜沉积与制备、等离子体刻蚀、等离子体表面织构、等离子体表面改性、晶片清洗



广泛的应用范围

- 光伏行业（氮化硅/非晶硅/微晶硅/等离子体织构与刻蚀）
- 新型二维材料（石墨烯/二硫化钼等的表面改性及制备）
- 半导体工艺（刻蚀工艺/氮化硅与二氧化硅工艺等）
- 纳米材料的生长与纳米形貌的刻蚀构造

